



Паспорт
на микросхемы
ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
„И-НЕ/ИЛИ-НЕ“
2ЛБ042
ЩИЗ. 402.006 П

СОДЕРЖИТ ДРАГ.
МЕТАЛЛ

УО ШТ

1971

478-8 (1) XI-71

Основные технические характеристики микросхемы

1. Режим работы

Максимальная потребляемая мощность от источника питания 56 мвт

Напряжение питания $\pm 4\text{В} \pm 10\%$

2. Основные электрические параметры (при $T = 25 \pm 10^\circ\text{C}$):

а) Входного сигнала

амплитуда 2,5 В

длительность

импульса 0,4-1,0 мксек

длительность

фронтов $\leq 0,1$ мксек

частота

контроля ≤ 500 кГц

полярность положительная

б) Выходного сигнала

на коллекторных выходах
напряжение $\leq +0,6\text{В}$; $\geq +3,3\text{В}$

фронт спада $\leq 0,3$ мксек

на выходах эмиттер-

ных повторителей

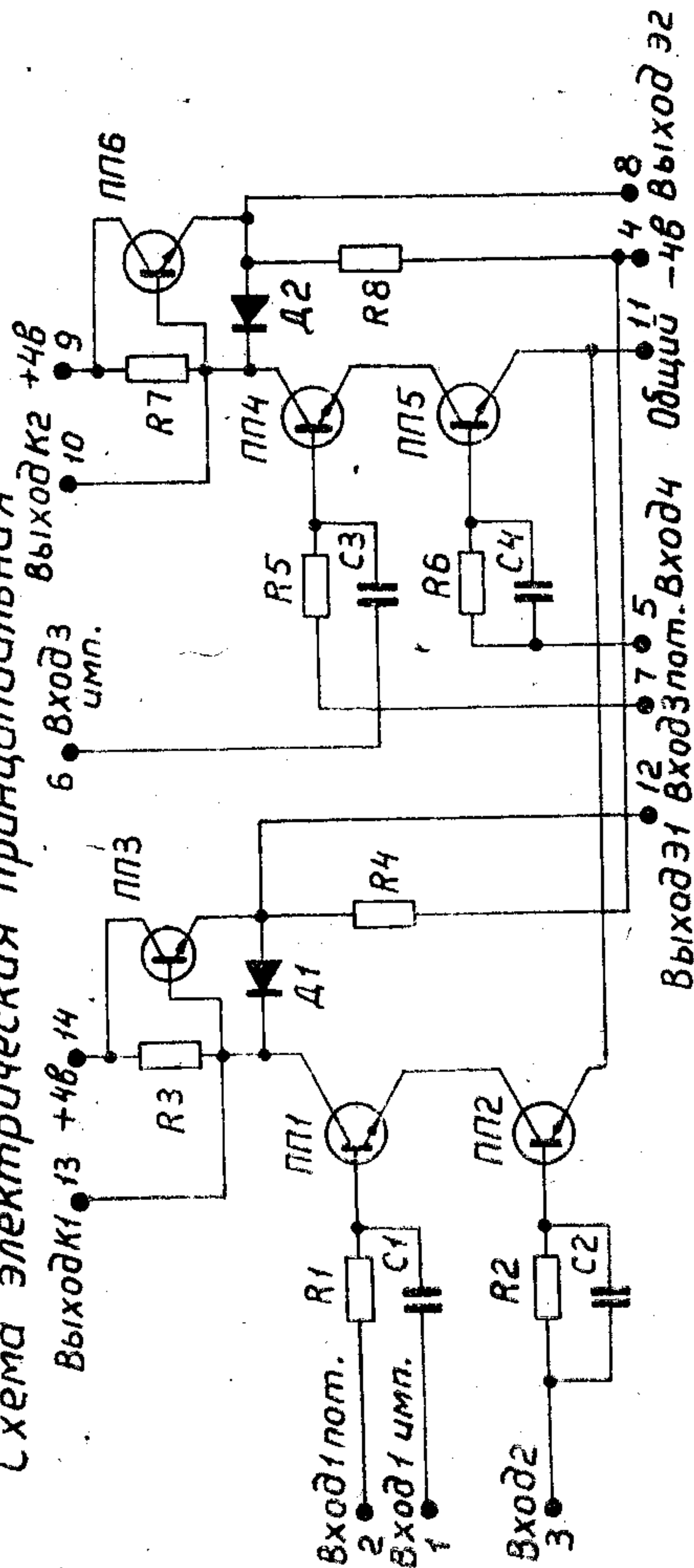
напряжение $\leq -0,1\text{В}$; $\geq +2,4\text{В}$

фронт нараста-

ния $\leq 0,15$ мксек

фронт спада $\leq 0,2$ мксек

Схема электрическая принципиальная



Вариант I Д1, Д2 - диодные матрицы типа 2Д910А или 2Д910Б
ЦИЗ.360.000ТУ

$R1=R2=R5=R6=3,5 \text{ кОм} \pm 10\%$

$R4=R8=6,2 \text{ кОм} \pm 10\%$

$R3=R7=1,3 \text{ кОм} \pm 10\%$

$C1=C3=160 \text{ пФ} \pm 20\%$

$C2=C4=82 \text{ пФ} \pm 20\%$

Вариант I ПП1, ПП4 - транзисторы типа 2Т317Б2

ГеЗ.365.002ТУ

Вариант I ПП2, ПП3, ПП5, ПП6 - транзисторы типа 2Т317Б2 или 2Т317В2

ГеЗ.365.002ТУ

ГеЗ.365.002ТУ

Вариант II Д1, Д2 - диодные матрицы типа ББЗВ ТТЗ.362.122ТУ

ББЗВ ТТЗ.362.122ТУ

Вариант II ПП1, ПП4 - транзисторы кремниевые типа А510В

ЖКЗ.365.212ТУ

ЖКЗ.365.212ТУ

Вариант II ПП2, ПП3, ПП5, ПП6 - транзисторы кремниевые типа А510Б

ЖКЗ.365.212ТУ

ЖКЗ.365.212ТУ

Примечание. Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки.

Время задержки

фронта нарастания $\leq 0,1 \text{ мксек}$

фронта спада $\leq 0,15 \text{ мксек}$

2а. Указание содержания драгоценных металлов: См. в штампе „Содержит драгметаллы.“

3. Рекомендации по установке микросхем

При монтаже микросхемы устанавливаются на печатные платы вплотную, крепление к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом припайки к выводам без какого-либо механического крепления.

Микросхема ставится на плату до упора, выводы отгибаются на контактные площадки платы и оплавляются. При этом температура пайки не должна быть более 300°C , время касания каждого вывода микросхемы не должно превышать 3 сек. Интервал между пайками соседних выводов должен быть

не менее 3 сек.

4. Предельно-допустимые условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 60°C до $+70^\circ\text{C}$.

Относительная влажность воздуха (30 суток) 98% при $T = +40^\circ\text{C}$.

Атмосферное давление от 5 мм рт.ст. до 3 атм.

Вибрация с ускорением до 40 g в диапазоне частот 5–5000 гц.

Многократные удары с ускорением до 150 g.

Одиночные удары с ускорением до 1000 g.

Линейные (центробежные) ускорения до 150 g.

5. Время гарантийной наработки 10000 час

6. Срок хранения 12 лет

7. Гарантия предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставляемых микросхем требованиям ОТУ и ЧТУ и произво-

дит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим преysкурантам, если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют соответствующим требованиям ОТУ и ЧТУ при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости этих микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

Гарантия исчисляется со дня приемки их ОТК или

представителем заказчика

" " " " 19 2.

Представитель ОТК ОТК 561
(штамп)

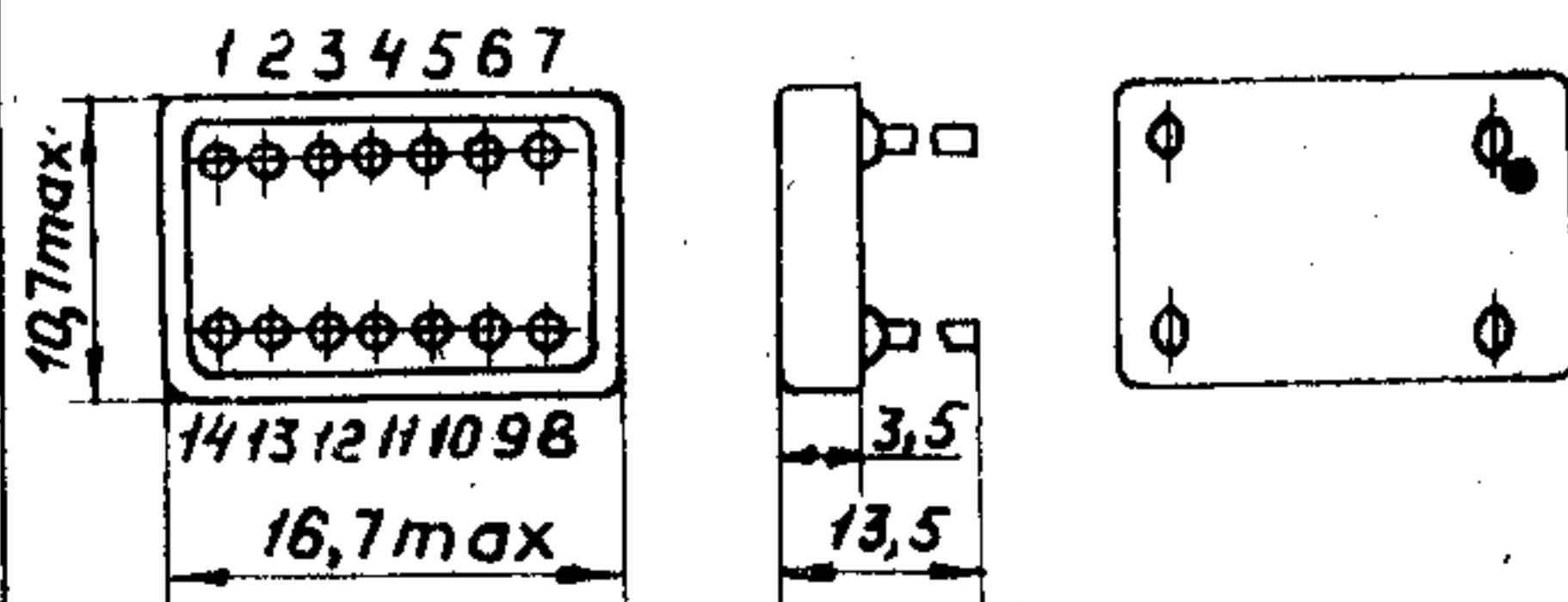
" 25 " 4 1973 г.

Представитель

заказчика 27 " 4 1973 г.
(штамп)



Габаритный чертеж



Вес микросхемы не более 1,1г.